

Université Hassan Premier Faculté des sciences et techniques Settat



Chapitre 5 : Les mémoires LST GI

par Mohamed HASSOUN

Définition

Définition

la mémoire est un dispositif électronique qui sert à stocker des informations. C'est un composant essentiel, présent dans tous les ordinateurs, les consoles de jeux, les GPS et de nombreux appareils électroniques.



Organisation d'une mémoire

La mémoire principale est caractérisée par:

Taille d'un mot mémoire M

Taille de l'adresse mémoire A

Nombre de mot mémoire



3

Organisation d'une mémoire

		A=3k	oits					M	1 = 8	3bits	
	/	@ 000									1 er mot mémoire : 11001001 est à l'@ 000
		@ 001	0	1	0	1	1	0	0	0	2 ème mot mémoire : 11001001 est à l'@ 001
		@ 010	1	0	0	0	1	0	1	1	3 ème mot mémoire : 11001001 est à l'@ 010
_ ^<		@ 011	1 1 1 0	0	0	0	1	4 ème mot mémoire : 11001001 est à l'@ 011			
2A •		@ 100	1	0	0	1	0	1	0	0	5 ème mot mémoire : 11001001 est à l'@ 100
		@ 101	1	0	1	1	1	1	0	0	6 ème mot mémoire : 11001001 est à l'@ 101
		@ 110	0	1	0	1	0	1	1	0	7 ème mot mémoire : 11001001 est à l'@ 110
		@ 111	1	1	0	1	1	0	0	0	8 ème mot mémoire : 11001001 est à l'@ 111
'											

Nombre de mots mémoire

Taille de la mémoire = 2^{A*} M

Organisation d'une mémoire

Exemple: dans une mémoire la largeur du bus d'adresses m=16 bits et la largeur du bus de données a = 8

Calculez la taille de cette mémoire?

NB d'@ = 2^{16} = 65536 mot mémoire de 8 bits

Taille de la mémoire = 65536 * 8 = 524288 bits

Caractéristiques d'une mémoire

- La capacité (taille): c'est le nombre de bits ou d'octets que peut contenir une mémoire ex:500 Go
- La largeur du mot mémoire : est l'unité de base pour le stockage dans la mémoire.
- Le temps d'accès : c'est le temps pour la lecture ou l'écriture d'un mot mémoire
- Le temps de cycle mémoire : c'est le temps minimum entre deux accès mémoire
- Volatilité : le besoin d'alimentationélectrique continue pour conserver l'information qui y est enregistrée
- Débit : c'est le nombre d'information lu ou écrit par seconde.
- Dual-channel : technologie gérée par le contrôleur mémoire permettant de doubler théoriquement ledébit

Caractéristiques d'une mémoire

Le débit théorique de la mémoire dépend de trois facteurs:

- La fréquence du bus FSB reliant le CPU à la mémoire
- La largeur du bus (en nombre de bits)
- Un coefficient, un multiplicateur qui dépend de la technologie utilisée (normal=1, DDR=2,....).

Débit = fréquence * largeur * coefficient

OU

Débit = largeur mot mémoire / cycle mémoire

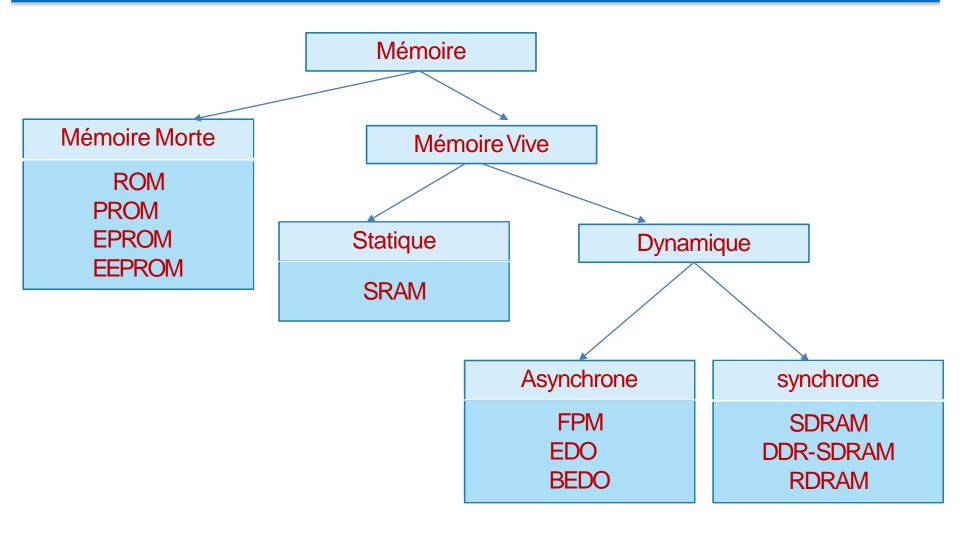
Caractéristiques d'une mémoire

Exemple 1: un ordinateur doté d'un FSB à 133 MHz et d'une largeur de 64 bits utilisant la technologie DDR, il possède un débit mémoire théorique :

Exemple 2 : considérons une mémoire avec un cycle de 1,2 ms et des mot mémoire d'une largeur de 32bits, donc le débit mémoire théorique :

$$32/1,2*10^6 = 30*10^3$$
 bits/s

Types de mémoires



Types de mémoires

Les mémoire morte ROM (read only memory) sont des circuits intégrés dans la carte mère, elles contiennent des données gravées lors de la fabrication de cette puce. Donc on peut pas les modifier.

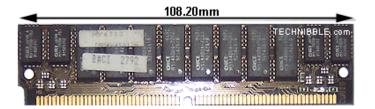
- PROM (Programmable ROM): c'est une rom qui programmée une seul fois par l'utilisateur.
- EPROM (Erasable PROM): Effaçable par des rayons ultra violet (UV).
- EEPROM (Electrically EPROM): est une mémoire effaçable et programmable électriquement
- FLASH ROM: la mémoire flash s'apparente avec latechnologie EEPROM.
 Elle est effaçable et programmable électriquement

Types de mémoires

La mémoire vive ou RAM (Random Access Memory) sert au stockage temporaire de données. Les mémoire sont en générale volatile.

- Static RAM: ne nécessite pas de rafraichissement (conserve l'information sur plusieurs heurs).
- Dynamic RAM : nécessite le rafraichissement de l'information plusieurs fois par seconde
 - Mémoire Asynchrone : le processeur ne peut pas engager un nouvel accès tant que l'accès précédent n'est pasterminé.
 - FPM: Faste page Mode
 - EDO: Extended Data Out
 - BEDO: Burst EDO
 - Mémoire Synchrone : le processeur peut engager des accès consécutifs même si l'accès précédent n'est pasachevé.
 - SDRAM: Synchronous DRAM
 - DDR-SDRAM: Double Data Rate SDRAM
 - RD-RAM: Direct Rambus SDRAM

Exemples de boitiers



EDO RAM



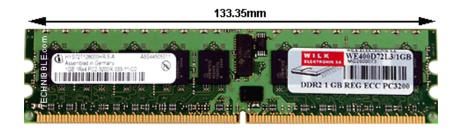
RAMBUS (RIMM) RAM



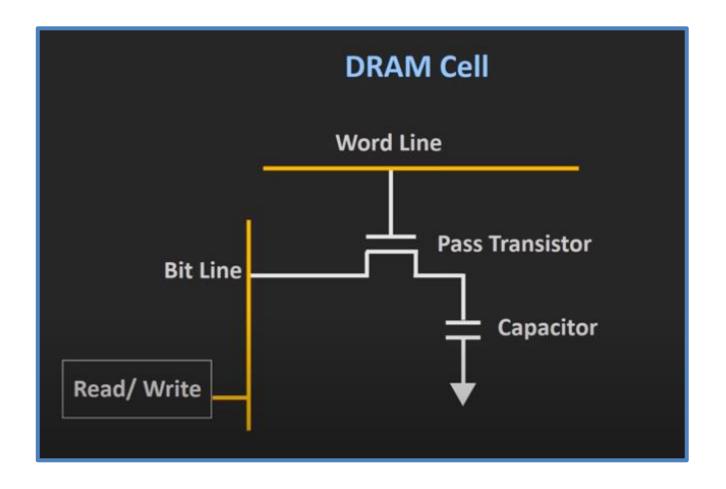
SDRAM

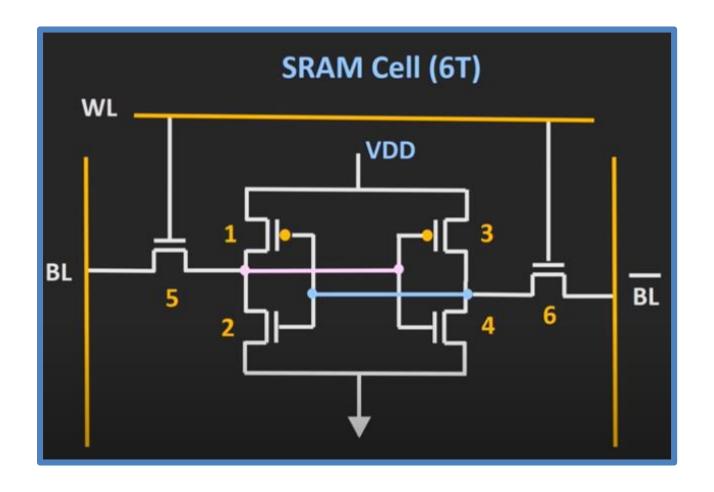


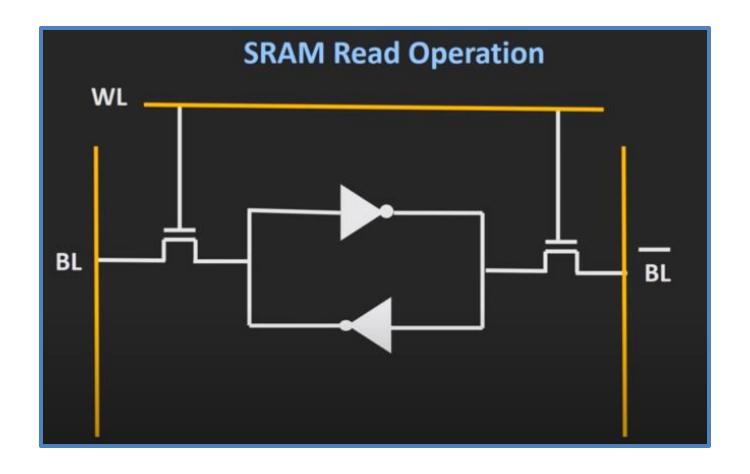
FPM RAM

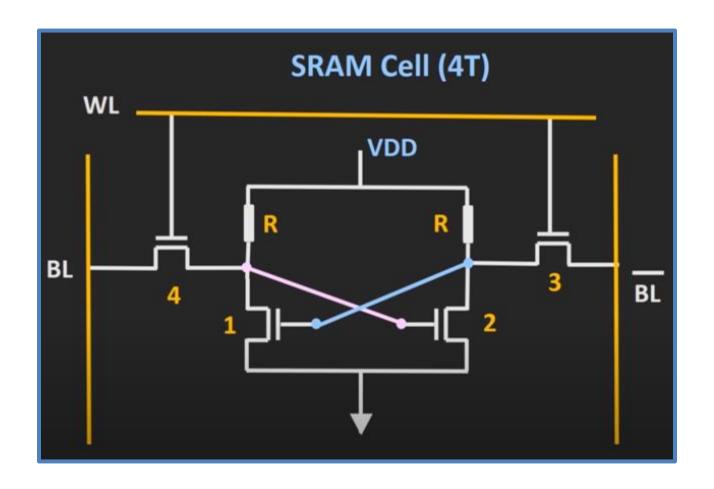


DDR2 RAM

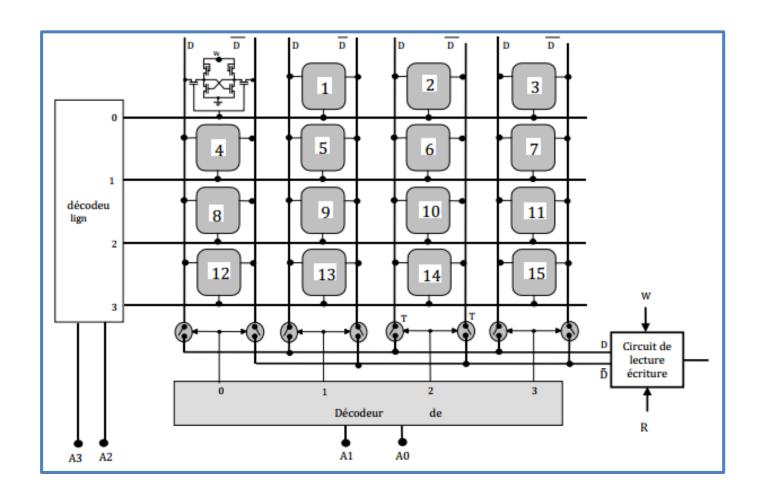


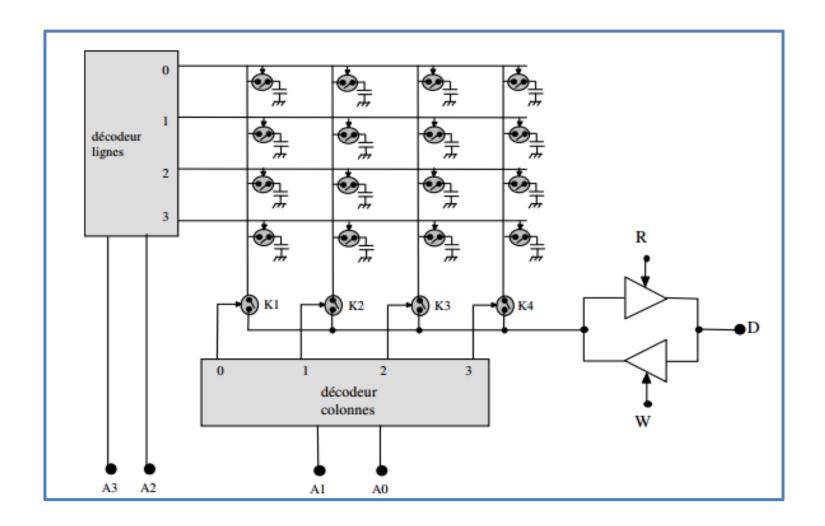




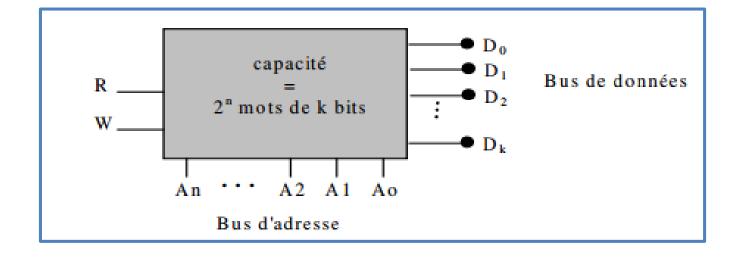


	SRAM (Static RAM)	DRAM (Dynamic RAM)		
Usage	Cache Memory	Main Memory		
Speed	Very Fast	Fast		
Cost	Costly	Cheaper than SRAM		
Density	Low	High		

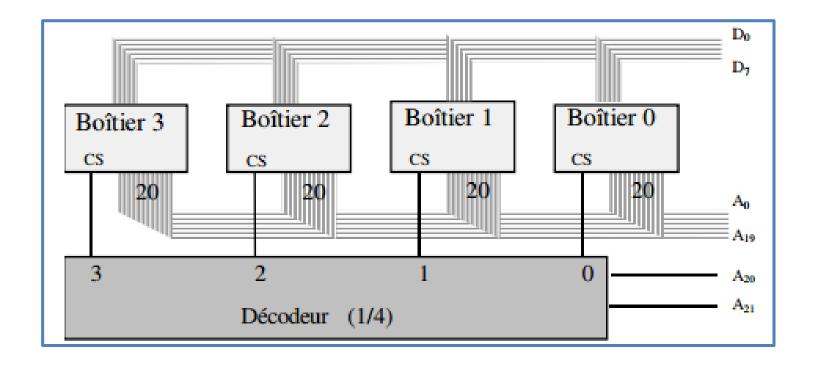




Vue Externe



Association de memoires



Plage d'adresses

Position	Adresse (Hexa)	Adresse (Dec)
1er boîtier	$000000 \rightarrow 0FFFFF$	0→1048575
2 ^{ème}	100000→1FFFFF	1048576→2097151
boîtier		
3ème	$200000 \rightarrow 2FFFFF$	2097152→3145727
boîtier		
4ème	$300000 \rightarrow 3FFFFF$	3145728→4119430
boîtier		4

Nb bits	Capacité				
adresse					
10	1024	1 ko			
11	2048	2 ko			
12	4096	4 ko			
13	8192	8 ko			
14	16384	16 ko			
15	32768	32 ko			
16	65536	64 ko			
17	131072	128 ko			
18	262144	256 ko			
19	524288	512 ko			
20	1048576	1 Mo			
21	2097152	2 Mo			
22	4194304	4 Mo			
23	8388608	8 Mo			
24	16777216	16 Mo			
25	33554432	32 Mo			
26	67108864	64 Mo			